**NXP, 미 애리조나 주 신규 질화갈륨 팹으로**

**5G 기술 고도화**

*미국 내 가장 최첨단의 RF용 GaN 대량 생산 시설*

* NXP 경영진, 애리조나 주지사를 포함한 미 지역, 주, 연방 정부 및 국제 정부 관계자들이 비대면 준공식에 참석해 기조연설 및 축사 진행
* NXP는 전력 밀도, 이득 및 선형화 효율성에 초점을 맞춘 새로운 150mm(6") 팹과 20년 간의 GaN 개발 노하우를 바탕으로 5G 셀룰러 인프라 확장을 선도
* 최첨단 팹은 현지 NXP 연구개발팀과 새로운 자체 공장 간의 강력한 협업을 통해 NXP의 혁신을 가속화하는 허브 역할을 수행할 것

**2020년 9월 29일 –** NXP 반도체는 미국 애리조나주 챈들러에 미국 내 5G RF 전력 증폭기 전용 생산 공장 중 가장 최첨단 시설인 150mm(6인치) RF [질화갈륨(GaN) 팹(Fab)](https://www.nxp.com/video/gan-experience-360-gan-fab-tour%3AGAN-360-FAB-TOUR)을 오픈했다고 발표했다. 신규 자체 공장은 RF 전력 업계 선두주자인 NXP의 전문성과 대량 생산 노하우를 접목해 산업·항공·방산 시장에서 5G 기지국과 첨단 통신 인프라 확충을 지원하는 효율적 혁신을 가능하게 할 것이다.

[준공식](https://www.nxp.com/company/our-company/events/rf-gan-experience%3ARF-GAN-EXPERIENCE?tid=vanRFGaN)을 기념하기 위해 NXP 경영진 외에도 다음과 같은 연방, 주 및 지방 정부 관계자가 참석해 기조연설과 축사를 전했다.

* 키어스틴 시네마(Kyrsten Sinema)와 마사 맥샐리(Martha McSally) 애리조나주 상원의원
* 그레그 스탠턴(Greg Stanton) 미국 연방 하원의원
* 더그 듀시(Doug Ducey) 애리조나 주지사
* 케빈 하트케(Kevin Hartke) 챈들러 시장
* 조셉 셈사르(Joseph Semsar) 미 상무부 국제무역담당 차관보
* 안드레 해스펠스(Andre Haspels) 주미 네덜란드 대사

커트 시버스(Kurt Sievers) NXP 최고경영자(CEO)는 기조연설에서 "오늘은 NXP에 중대한 이정표가 되는 날”이라며 “애리조나에 이렇게 훌륭한 시설을 구축하고 핵심 인재를 활용함으로써 NXP가 차세대 5G 기지국 인프라를 견인하는 일환으로 GaN 기술에 집중할 수 있게 됐다"고 말했다.

**질화갈륨: 5G의 새로운 기준**

5G에서는 안테나당 요구되는 RF 솔루션 밀도가 기하급수적으로 증가했지만, 동일한 박스 크기를 유지하고 전력 소비량을 줄이는 것이 필수적이다. GaN 전력 트랜지스터는 이러한 필수 요건을 충족하기 위한 새로운 기준으로 떠오르면서 전력 밀도와 효율성을 모두 크게 개선하고 있다.

약 20년간 쌓아온 GaN 개발 노하우와 무선통신산업에 대한 광범위한 지식으로 NXP는 [차세대 5G 셀룰러 확장](https://www.nxp.com/video/gan-experience-about-5g%3AGAN-EXPERIENCE-ABOUT-5G)을 선도하는 고유한 위치에 올랐다. 최고 품질의 GaN 기기를 NXP 고객에게 제공하기 위해 집중한 결과, GaN 기술의 심도 깊은 최적화를 통해 반도체 전자 트래핑을 개선하여 고효율과 [동급 최고](https://www.nxp.com/video/gan-experience-linearizing-gan-in-the-lab%3AGAN-LINEARIZING-IN-THE-LAB)의 선형성을 갖추게 되었다.

NXP의 오랜 고객인 에릭슨(Ericsson)의 개발 유닛 네트워크 책임자인 요아킴 솔리우스(Joakim Sorlius)는 "에릭슨은 고객에게 최대의 가치를 제공하는 업계 선도적인 제품을 제공하기 위해 노력하고 있으며 전력 증폭기는 무선 기술에서 중요한 역할을 한다. 에릭슨의 최근 미국 투자와 마찬가지로, 미래 수요가 높은 무선 네트워크를 위한 RF 시스템 성능 향상에 지속적으로 초점을 맞춘 NXP의 미국 반도체 공정 개발 투자 행보를 기쁘게 생각한다."고 말했다.

**NXP의 빠른 GaN 혁신과 완벽 품질 추구 정신에 기반한 최첨단 팹**

NXP의 자체 [GaN 팹](https://www.nxp.com/video/rf-gan-experience-gan-fab-equipment-build-time-lapse%3AGAN-FAB-EQUIPMENT-BUILD) 구축 전략은 셀룰러 인프라 설계 핵심 역량, 입증된 양산 실적, 전체 품질 공정에서의 일관성과 리더십을 활용하여 더 높은 성능 이점을 달성할 수 있는 능력에 기반해 추진되었다.

NXP 무선 전력 그룹의 폴 하트(Paul Hart) 수석부사장 겸 총괄은 "이번 챈들러 신규 공장 준공은 지난 수십 년 동안 GaN과 통신 인프라 시장에서 노력해 온 NXP의 성과"라며 "오랫동안 우리와 협업을 이어온 고객사들, 그리고 6G 이상까지 확장할 수 있도록 설계되고 준비된 세계 최고 기술의 RF GaN 팹을 만드는데 큰 역할을 해주신 NXP 팀 전체에 감사드린다"고 소감을 전했다.

챈들러에 기반을 둔 팀과 복합 반도체 제조에 대한 오랜 전문성을 활용하여 NXP의 신규 팹은 빠르게 성장할 것으로 전망된다. 더그 듀시(Doug Ducey) 애리조나 주지사는 "챈들러에 있는 최첨단 신규 제조 시설을 통해 애리조나주는 신기술의 제조 허브이자 5G 혁신의 선구자로서 명성을 확대할 것"이라며 "NXP가 애리조나주에 일자리와 투자를 늘린 것에 감사한다"고 덧붙였다.

이 자체 공장은 팹과 현장의 NXP R&D팀 간 협업을 촉진하는 혁신 허브 역할을 하게 된다. NXP 엔지니어들은 현재 및 미래 세대의 GaN 기기를 위한 기술을 더욱 신속하게 개발, 검증 및 보호할 수 있으며, 결과적으로 NXP GaN 기술 혁신에 걸리는 시간을 단축할 수 있다.

**가용성**

챈들러에 위치한 NXP의 신규 GaN 팹은 현재 인증을 받았으며, 초기 제품들이 시장에 출시되었고 2020년 말에 완전 가동될 것으로 예상된다.

**NXP RF GaN 팹 오프닝 보기**

여기를 클릭하면 NXP 경영진 및 정부 관계자의 기조연설, 팹 투어, GaN 기술 세션, NXP의 RF 리더 및 업계 분석가들과 함께한 5G에 대한 패널 토론을 볼 수 있다.

**NXP 반도체 소개**

NXP® 반도체(나스닥: NXPI)는 더욱 편리하고 안전하며 더 나은 삶을 위한 첨단 솔루션을 개발하여, 안전하게 연결되는 스마트 월드를 만들고 있다. NXP는 임베디드 애플리케이션용 보안 연결 솔루션의 선도 기업으로서, 자동차, 산업 및 IoT, 모바일, 통신 인프라 시장의 혁신을 주도하고 있다. NXP는 60년 이상의 전문성과 경험을 바탕으로, 전 세계 30개 이상의 국가에서 30,000명의 직원을 고용하고 있다. 2019년 매출은 미화88억 8천만불이다. NXP 관련 뉴스는 [www.nxp.com](http://www.nxp.com)에서 찾아볼 수 있으며, NXP 반도체 블로그 (<http://blog.naver.com/nxpkor>) 에서도 NXP 관련 정보를 확인할 수 있다.